
	<h2>SIRC16DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIRC16DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 60A POWERPAKSO-8</p> <p>Datenblätter:  SIRC16DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIRC16DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 60A POWERPAKSO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	0.96 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	54.3W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIRC16DP-T1-GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5150pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 60A (Tc) 54.3W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SIRC16DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIRC16DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIRC16DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIRC16DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIRC10DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SIRB40DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 40V 40A SO8</p>	 <p>SIRC18DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SIRCOMM2 N/A N/A SOP8</p>
 <p>SIRC16DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 60A SO8</p>	 <p>SIRC330 SILAN SILAN RECEIVER</p>	 <p>SIRC430M3B Silan Silan DIP-3</p>	 <p>SIRB40DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 40V POWERPAK SO8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIRC16DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIRC16DP-T1-GE3 Datenblatt	SIRC16DP-T1-GE3-Datenblätter	SIRC16DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIRC16DP-T1-GE3
SIRC16DP-T1-GE3 Electronic	SIRC16DP-T1-GE3-Komponenten	SIRC16DP-T1-GE3-Verteiler	SIRC16DP-T1-GE3-Bild	SIRC16DP-T1-GE3-Teil
SIRC16DP-T1-GE3 Preis	SIRC16DP-T1-GE3 Hersteller	SIRC16DP-T1-GE3 Bild	SIRC16DP-T1-GE3 Aktie	SIRC16DP-T1-GE3 Inventar
SIRC16DP-T1-GE3 Neu	SIRC16DP-T1-GE3 Original	SIRC16DP-T1-GE3 garantiert	SIRC16DP-T1-GE3 RFQ	SIRC16DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited